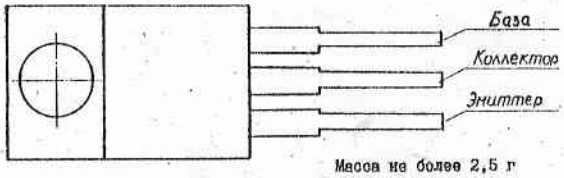
ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы типов КТ819А,КТ819Б,КТ819В, КТ819Г в пластмассовом корпусе, предназначенные для применения в ключевых и линейных схемах, узлах и блоках аппаратуры широкого применения.



Масса не более 2,5 г

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ $T_{ср}$ =(25 ± 10) °С

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения, тип транзистора	Буквенное обозначение	Норма не менее	Норма не более
Статический коэффициент передачи тока ($I_э$ = 5 А, $U_{кб}$ = 5 В)	$h_{21э}$		
КТ819А, КТ819В		15	275
КТ819Б		20	275
КТ819Г		12	275
Обратный ток коллектора, мА ($U_{кб}$ = 40 В)	$I_{кбо}$		1
Граничное напряжение, В ($I_э$ = 0,3 А, $t_и$ = 270-330 мкс)	$U_{кэо гр}$		
КТ819А		25	
КТ819Б		40	
КТ819В		60	
КТ819Г		80	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_к$ = 5 А, $I_б$ = 0,5 А)	$U_{кэ нас}$		2

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В 1000 шт. ТРАНЗИСТОРОВ:

серебро - 0,0222 г

Содержание цветных металлов в транзисторе:

Медь - 1,5 г

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ819А,КТ819Б,КТ819В,КТ819Г соответствуют техническим условиям аА0.336.189 ТУ/02

Место для штампа ОТК

Место для штампа "Перепроверка произведена

Место для штампа ОТК

conector.by